

国产高纯锗晶体生长及探头制备进展

Thursday, 9 May 2024 15:00 (20 minutes)

本文介绍国产高纯锗晶体生长及探头制备进展。经过区熔提出、单晶提拉等工序，获得 13N 高纯锗晶体，最大合格尺寸达到 $\phi 80 \times 70 \text{mm}$ 。高纯锗探头制备包含 13N 高纯 P 型晶体电极制备工艺，制冷封装设计及组装工艺。制备的高纯锗探头探测效率 40%，能量分辨率达到 0.4%，漏电流达到 200pA。

Collaboration (if any)

Primary author: Mr 张, 伟 (安徽光智科技有限公司)

Co-author: 狄, 聚青 (安徽光智科技有限公司)

Presenter: Mr 张, 伟 (安徽光智科技有限公司)

Session Classification: 09 - 探测器物理与技术

Track Classification: 09 - 探测器物理与技术